

**(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG**

**(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro**



**(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. März 2005 (24.03.2005)**

PCT

**(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/026041 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B81C 1/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/001449

(22) Internationales Anmeldedatum:
7. Juli 2004 (07.07.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 42 155.6 12. September 2003 (12.09.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

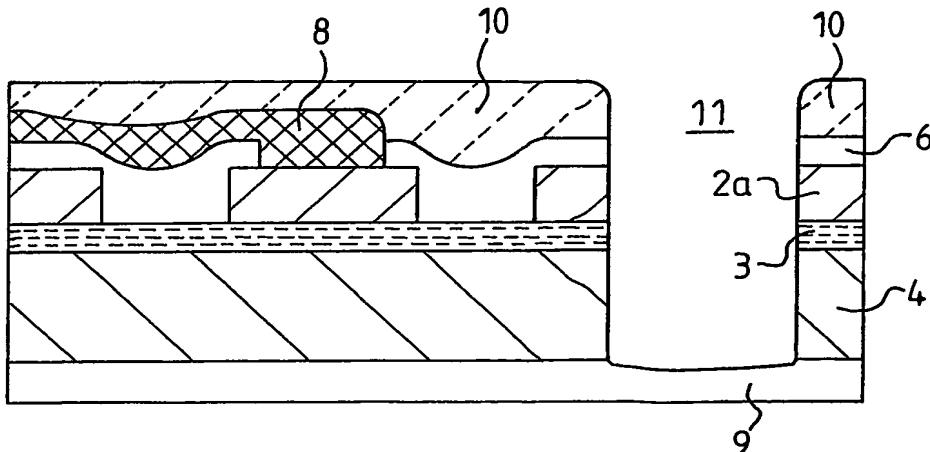
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RUDHARD, Joachim [DE/DE]; Langwiesenstrasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF ETCHED HOLES AND/OR ETCHED TRENCHES, AND MEMBRANE SENSOR UNIT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ÄTZLÖCHERN UND/ODER ÄTZGRÄBEN SOWIE MEMBRANSENSOREINHEIT



WO 2005/026041 A1

(57) Abstract: Disclosed is a method for producing etched holes and/or etched trenches (11) in components that are based on silicon or a silicon/insulator layer structure. According to said method, a germanium-containing layer and/or a germanium layer (9) is/are provided at the point in the etching direction where or near which an etching process is to be completed. Germanium and/or germanium compounds is/are detected during the etching process, and the etching process is controlled, particularly aborted, in accordance with the detection of germanium and/or germanium compounds. Also disclosed is a membrane sensor unit whose layer structure is provided with a germanium layer and/or a germanium-containing layer.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Ätzlöchern und/oder Ätzgräben (11) von auf Silizium bzw. einem Schichtaufbau Silizium/Isolator basierenden Bauteilen vorgeschlagen. Erfindungsgemäß wird eine germaniumhaltige Schicht und/oder eine Germaniumschicht (9) an der Stelle in Ätzrichtung vorgesehen, an welcher oder in deren Umgebung ein Ätzvorgang beendet werden soll. Während des Ätzvorgangs wird auf Germanium- und/oder Germaniumverbindungen eine Detektion durchgeführt und in Abhängigkeit von der Detektion von Germanium und/oder Germaniumverbindungen der Ätzvorgang gesteuert, insbesondere abgebrochen. Außerdem wird eine Membransensoreinheit vorgeschlagen, in deren Schichtaufbau eine Germanium- und/oder germaniumhaltige Schicht vorgesehen ist.



KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.